糖類により多重修飾された層状粘土 鉱物による不斉選択的触媒反応

(課題番号07651073)

平成8年度科学研究費補助金 (一般研究(C)) 研究成果報告書

平成9年3月

研究代表者___<u>島津_</u>省吾__ (千葉大学工学部助教授)

糖類により多重修飾された層状粘土 鉱物による不斉選択的触媒反応

(課題番号 07651073)

平成8年度科学研究費補助金 (一般研究(C)) 研究成果報告書

平成9年3月

研究代表者 島津 省吾

(千葉大学工学部助教授)

研究組織

研究代表者: 島 津 省 吾

(千葉大学工学部助教授)

研究経費

平成7年度	1、700千円
平成8年度	500千円
計	2、200千円

研究発表

学会誌等

- (1) S. Shimazu, K. Ro, T. Sento, N. Ichikuni, and T. Uematsu, Asymmetric Hydrogenation of Unsaturated Carbonul Compounds by Clay-Supported Rhodium complexes, *Proceedings of the* 1995 International Conference on Ion Exchange, pp. 23-28 (1995).
- (2) T. Uematsu, N. Ichikuni, S. Shimazu, Modification of Layer Compounds for Host-Guest Catalysis, Proceedings of the 1995 International Conference on Ion Exchange, pp. 275-2280 (1995).
- (3) S. Shimazu, K. Ro, T. Sento, N. Ichikuni and T. Uematsu, Asymmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Carboxylic Acid Esters by Rhodium(I) Phosphine Complexes Supported on Smectites, J. Mol. Catal. A: Chemical, 107, 297-303 (1996).
- (4) 島津省吾,ソフト化学的手法によるイオン交換体の化学修飾と分子認識触媒への応用、日本イオン交換学会誌、8(1)、2-16 (1997).
- (5) Shimazu, K. Uematsu, N. Ichikuni, and T. Uematsu, Intercalation of Rhodium(I)-Chitosan Complex into Hectorite and Its Catalytsis for Asymmetric Hydrogenation of Itaconetes, *Chem. Letters* (1997) (投稿予定).

口頭発表

- (6) S. Shimazu, K. Ro, N. Ichikuni, T. Uematsu, Aymmmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Carboxylic Acid Esters by Rhodium(I) Complexes Supported on Smectites, 8th International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis (Balatonfured), Sept. 12, 1995.
- (7) S. Shimazu, Preparation of Clay-Supported Metal Complexes and Application to Catalyses for Molecular Recognition Reactions, *Catalysis Seminar (ETH, Zurich)*, Sept. 22, 1995.
- (8) 島津省吾、前田義明、一國伸之、上松敬禧、ヘクトライト層間固定化ロジウム錯体による不斉水素化反応とアミンの添加効果、平成7年度触媒研究発表会、触媒学会(室蘭工業大学)、講演番号 3C26(1995年10月7日)
- (9) 仙頭 準、島津省吾、一國伸之、上松敬禧、ヘクトライト層間固定化ロジウム錯体による不斉水素化反応、第11回ゼオライト研究発表会、ゼオライト研究会(鳥取大学)、講演番号(1995年11月9日).
- (10) 島津省吾、仙頭 準、一國伸之、上松敬禧、層間固定化Rh錯体によるイタコン酸エ ステルの不斉水素化反応、日本化学会第70春季年会、日本化学会(青山学院大学)、

講演番号2D412(1996年3月29日).

- (11) 島津省吾、植松克也、一國伸之、上松敬禧、糖を配位子とする金属錯体の合成と粘 土鉱物層間への固定化、日本化学会第70春季年会、日本化学会(青山学院大学)、講 演番号2C415(1996年3月29日).
- (12) 島津省吾、田崎 賢、一國伸之、上松敬禧、層間固定化ロジウム錯体によるイタコン酸エステルの不斉水素化-基質のサイズ依存性、平成8年度触媒研究発表会、触媒学会(九州大学)、講演番号 6C18(199610月10日).
- (13) 粂野正樹、一國伸之、島津省吾、上松敬禧、アミロース誘導体を配位子とする遷移 金属錯体の粘土鉱物層間への固定化と触媒作用、第12回日本イオン交換研究発表会、日 本イオン交換学会、講演番号A101(1996年11月11日).
- (14) 植松克也、一國伸之、島津省吾、上松敬禧、糖遷移金属錯体の粘土鉱物層間固定化 とその触媒挙動、第12回日本イオン交換研究発表会、日本イオン交換学会、講演番号 P10(1996年11月11日).
- (15) 島津省吾、ソフト化学的手法によるイオン交換体の化学修飾と分子認識触媒への応用、第12回日本イオン交換研究発表会、日本イオン交換学会、受賞講演(1996年11月11日).
- (16) 島津省吾、植松克也、一國伸之、上松敬禧、粘土鉱物層間で構造制御されたキトサン-ロジウム錯体の触媒挙動、シンポジウム「コンセプチュアルアプローチ in 触媒」、触媒学会(工学院大学)、講演番号7(1996年12月12日).
- (17) 島津省吾、仙頭準、一國伸之、上松敬禧、層間で構造制御されたRh錯体による不飽 和カルボン酸エステルの不斉水素化、シンポジウム「ミクロ空間反応場を利用する分子 機能材料の設計と触媒機能」、触媒学会(東工大)、講演番号なし(1997年1月21日).
- (18) 島津省吾、植松克也、一國伸之、上松敬禧、層間固定化Rh(I)-キトサン錯体触媒による選択的水素化反応、日本化学会第72春季年会、日本化学会(立教大学)、講演番号 10138(1977年3月27日).
- (19) 島津省吾、仙頭準、一國伸之、上松敬禧:アルキルアンモニウム修飾したヘクトラ イト層間固定化Rh錯体による不斉水素化反応、日本化学会第72春季年会、日本化学会 (立教大学)、講演番号1D139(1977年3月27日).
- (20) Shogo SHIMAZU, Katsuya UEMATSU, Nobuyuki ICHIKUNI, and Takayoshi UEMATSU, Selective Hydrogenation Catalyzed by Rhodium(I)-Chitosan Complex Supported on Smectite, *International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals*, Japan Association of Zeolites(Waseda University), (1997年8月24日) (予定)
- 出版物
- (21) 築部浩 編、 島津省吾 分筆、分子認識化学、 三共出版 1997年3月10日.

研究成果

目次

- 1. 概要
- 2. 序論

3. 結果と考察

糖誘導体の構造解析 均一系触媒の構造解析と立体構造 Rh-Chito⁺/NaHTの構造解析と層間でのゲストの立体構造 触媒反応

イタコン酸ジエステルの不斉水素化反応 geraniol の部分水素化反応 citronellal の部分水素化反応

- 4. 総括
- 5. 参考文献

本文

1. 概要

層状粘土鉱物の層間に金属錯体を固定化すると、"限られた層空間"でゲスト錯体の配向 性が制御でき、さらに、錯体と反応基質との相互作用が高められ、分子認識能の向上が期待 される。また、高分子であり、多くの不斉炭素や誘導体化が容易な水酸基を持つ多糖類を、 金属錯体の配位子として用いることにより、錯体の安定性や不斉選択性の向上が期待される。 本研究では、粘土鉱物層間へのインターカレートによる触媒挙動の変化について検討した。

アミノ多糖類であるキトサンからフタルイミド誘導体(N-Chito)、さらに新規配位子としてホスファイト誘導体(N-Chito-OP)を合成し、これを $[Rh(COD)Cl]_2$ (COD=1,5-cyclooctadiene)と反応させ、Rh(I) 錯体 (Rh-Chito) を合成し、均一系触媒とした。これらの配位子及び錯体のキャラクタリゼーションを元素分析、 FT-IR 測定、旋光度測定により行った。

合成した Rh-Chito をカチオン交換によりスメクタイト系合成フッ素型ナトリウムヘクト ライト (NaHT) の層間にインターカレートし、層間固定化 Rh(I) 錯体 (Rh-Chito⁺/NaHT) を 調製、不均一系触媒とした。キャラクタリゼーションを FT-IR, XRD, TEM, EDS, 元素分析 により行った。FT-IR 測定により、Rh-Chito に基づく吸収が観測された。XRD 測定では、 底面間隔が 2.02 nm となり、クリアランススペースは 1.06 nm と見積もられた。さらに TEM 観測によっても、層間隔の拡大が確認され、ホストの層構造が数十 nm にわたり保持 されていることがわかった。EDS 測定により、定性的に Rh, P, Si, Mg などの存在が確認さ れた。以上のキャラクタリゼーションにより、粘土鉱物層間に錯体がインターカレートされ、 層間を拡大したと考えられる。これらの結果と錯体の分子サイズとを考慮すると、層間に錯 体の 1 分子層が形成されており、キトサン分子鎖はシリケート層に対してほぼ平行に配向 しているものと考えられる。

Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT を用いた以下に示す触媒反応を行った。キトサン配位子の立体

構造による不斉選択性の向上が期待されることから、プロキラルな化合物であるイタコン酸 ジエステルの不斉水素化反応を行った。また、キトサン配位子の化学的性質が従来のホスフ ィン配位子と異なることが予測されることから、不飽和アルデヒドである citronellal の部分 水素化反応を行い、選択性(chemoselectivity)を検討した。

イタコン酸ジエステルの不斉水素化は、反応管に溶媒 3 ml と反応基質、Rh-Chito または Rh-Chito⁺/NaHT を加え、303 K、水素 1 気圧で前処理後、反応を開始し、HPLC により反 応生成物の分析を行った。また、citronellal の水素化は、不斉水素化と同条件で前処理及び 反応を行い、GC で分析した。

イタコン酸ジエステルの不斉水素化反応では、Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT ともに、反応主 生成物として (R)-methylsuccinate が得られた。また、異性体であるメサコン酸エステル経由 の水素化反応も数 % 見られた。反応活性及び選択性は、反応溶媒に大きく依存した。すな わち、MeOH では反応が進行せず、錯体とより親和性の高い DMF を用いた場合には、初 期に反応は進行するものの途中で失活し、不斉選択性もほとんど得られなかった。そこで、 層間を拡大し、さらに Rh 錯体への配位を抑制するために DMF 量を調節した alcohol/DMF 混合溶媒を用いると、反応転化率が著しく向上した。

不斉選択性(e.e. (*R*)) については、Rh-Chito(反応溶媒 EtOH/DMF=1)を用いた場合、主 生成物として 3% の不斉収率で (*R*)-methylsuccinate が得られた(3% e.e. (*R*))のに対して、 Rh-Chito⁺/NaHT を用いた場合、不斉選択性が 8% e.e. (*R*) に向上した。各反応溶媒におい て均一系反応に比べて不均一系反応で高い値が得られ、錯体を粘土鉱物層間に固定化するこ とにより不斉選択性の向上が見られた。これは層間での規制されたゲスト錯体の立体構造 (2/1 らせん構造)が関与しているものと考えられる。

また、用いた混合溶媒中の DMF 比を減少すると均一系、不均一系反応ともに不斉選択性の向上が見られた。 DMF のみを用いた場合には、不斉選択性はほとんど得られていないことなどから、溶媒中の DMF による配位で、基質と錯体との相互作用が弱められていることがこの反応挙動の原因と考えられる。

反応の選択性は全体的に低く、その原因として錯体自体の問題が考えられることから、旋 光度について Rh-Chito と他の錯体との比較を行った。

他の基質として citronellal を用いて水素化反応を行い、C=C 基に対する C=O 基の水素 化選択性(chemoselectivity)を調べた。疎水性のホスフィン基を持つ [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ と異なり、Rh-Chito, Rh-Chito[†]/NaHT ともに、C=C 基に比べ C=O 基の方が水素化されやす いという傾向が見られた。これは、親水性の糖配位子が基質の C=O 基とより強く相互作用 するためと推測される。均一系、不均一系反応の差については、顕著な差が見られず、この 系での触媒挙動は配位子であるキトサン主鎖の効果が支配的であると考えられる。

2. 序論

層状粘土鉱物は層間による形状認識能や、静電場、疎水、親水性などを持つサイトが存在 していることから、層間自体が分子認識の反応場として利用できる。それに加え、層状粘土 鉱物をホストとし、ゲストとして触媒活性を有する有機金属錯体を層間内に固定化すること により、層空間によって錯体の構造が制御され、配向性が高まり、触媒の活性サイトと反応 基質との相互作用が強められ、不斉触媒反応において形状選択性、立体的選択性の向上が期待される。¹⁻³⁾しかし、従来ゲストとして用いてきた [Rh((S,S)-DIOP)(COD)]ClO₄, [Rh((S)-BINAP)(COD)]ClO₄ などの低分子錯体では選択性の向上は顕著ではなかった。⁴⁻⁶⁾

ゲストとして、高分子配位子を持つ錯体を用いることにより、遷移金属を中心とした錯体 の C₂ 対称構造よる不斉の誘導⁷⁻¹³⁾以外に、高分子の高次構造による不斉の誘導¹⁴⁾が期 待され、これにより選択性の向上が期待できる。高分子の中でも、多糖類は、液体クロマト グラフィーやガスクロマトグラフィーの不斉分割用カラム充填剤に利用され、^{15,16)}その高 次構造による高い分子認識能が示されており、¹⁴⁾また、誘導体化が容易な水酸基を多く持 っことなどから、¹⁷⁾多糖類の一種であるアミノ多糖類の誘導体を不斉配位子として用い、 高分子錯体の立体構造を層空間により制御することで、高選択性を持つ触媒が期待できる。

まず、ホストである層状粘土鉱物について以下に述べる。

ホストとして用いているスメクタイトは、代表的な粘土鉱物の一つであり、Si-O からな る四面体シートで Al-O, Mg-O などからなる八面体シートを挟み込んだ複合層を形成し、こ の複合層と、交換性陽イオン及びそれに配位した水分子からなる層間とが、積層構造を形成 している。Figure 1 にスメクタイト系合成フッ素型ナトリウムヘクトライト (NaHT)の層 構造を示す。積層構造は、層自体が持つ電荷による静電引力により保たれているが、その結 合は弱く、水やその他の溶媒で膨潤し、粒子径が非常に小さいため分散性が高い。また、イ オン交換能を持ち、無機物や有機物と層間化合物を形成するなどの物理的、化学的に特異な 性質を示す。なお、天然に産出するスメクタイトは純度や化学組成などに問題があることか ら、工業的に合成が行われている。合成フッ素型ナトリウムヘクトライトは、3 八面体型ス メクタイトに分類され、層間内の交換性陽イオンが Na イオンであり、八面体 Mg の一部 が Li で置換されていることにより、層電荷を持つ。^{18,19}

以上の構造、性質により、ゲストをインターカレートする際、他の非晶性担体、高分子担体とは異なったホストとして働き、そのため粘土層間に錯体を担持した場合、触媒反応への 効果として次のようなものが期待される。

・層構造による基質の形状選択性及びサイズ選択性

- ・インターカレートしたゲストの立体配向性による選択性の変化
- ・選択性に関する層間の静電場の効果
- ・層間での錯体の安定化
- ・触媒の回収、生成物の精製が容易

実際に、粘土鉱物を用いた不斉触媒反応において、Pinnavaia ら¹⁾や Mozzei ら²⁾ は不斉 配位子をもつ錯体が限られた層空間内に修飾されることにより、不斉配位子と反応基質との 相互作用が強められることを示した。 また、リン酸ジルコニウムを用いた不斉認識につい ても、Mallouk らが、層空間により不斉配位子と反応基質との相互作用が強められることを 示した。³⁾ つまり、不斉触媒反応において、触媒として用いられる金属錯体が金属と不斉配 位子からなっており、不斉配位子の立体障害により反応基質の金属への立体的な配座が決定 し、水素化などの反応で立体的選択性、不斉選択性が得られることから、⁷⁻¹⁰金属錯体を 粘土鉱物層間に固定化することによる、限られた層空間でのかさ高い不斉配位子を持つ金属 錯体と反応基質との相互作用の向上、これによる不斉認識性、選択性の向上を得ることがで きる。

また、有機金属錯体は活性と選択性が比較的高く、いろいろな金属原子を活性中心として 用いることができることなどから、有機金属錯体による均一系触媒の研究が行われているも のの、空気中で活性を失いやすく、金属製の反応容器に対して腐食性があり、反応終了後、 生成物との分離と回収が困難であるなどの点が挙げられ、これを克服するため、金属錯体を 無機酸化物、あるいは有機高分子²⁰⁾に担持した、固定化触媒(不均一系触媒)の調製が試 みられており、これらの触媒は、触媒の回収、生成物の精製といった点で均一系触媒より優 れたものである。その担体としては、先に述べたスメクタイト系層状粘土鉱物であるモンモ リロナイトやヘクトライト、ポリスチレンやポリアクリル酸などの有機高分子担体、シリカ やゼオライトなどの多孔性無機酸化物担体などが挙げられる。^{1,2,4-6,21,22)}

層状粘土鉱物にインターカレートするゲスト分子として、 [Rh((*S*,*S*)-DIOP)(COD)]ClO₄⁷⁾ や [Rh((*S*)-BINAP)(COD)]ClO₄²³⁾ といった、低分子配位子からなる錯体を使用してきたが⁴⁻⁶、高分子を配位子とした錯体をゲストとして用いることにより、次のような高分子効果が 期待できる。²⁴⁾

・単量体単位が連鎖的に結合してつながっており、官能基や錯体部を隣接 または分散して固定可能

・高分子により作られる環境効果(高分子鎖によるマトリックスの形成)

- ・官能基の存在の空間的な密度が低分子錯体溶液に比べて高い
- ・高分子がヘリックスなどの高次構造をとることによる立体効果
- ・キレート効果による錯体の解離の抑制(錯体生成定数が大きい)
- ・配位不飽和な中心金属の安定化

このような高分子効果は、実際に、高分子のマトリックスによる不活性二量体の生成の抑制や、²⁵⁾高分子配位子が錯体の不飽和配座を比較的安定に保持し、中心金属を保護することによる錯体の安定性の向上がある。^{26,27)}さらに、触媒反応においても、均一系反応と変わらない結果や、²⁸⁾高分子効果による選択性の向上など、²⁹⁾数多く報告されている。また、 生体内での酵素は穏和な反応条件で高活性、高選択性を持つ天然高分子触媒であり、高分子効果による特異な作用があると考えられる。以上のような高分子効果に加え、粘土鉱物層間からの錯体の流出を抑えるといった効果も得られる。

高分子錯体の配位子として、アミノ糖などの多糖類の誘導体を用いることにより、不斉触 媒反応において、上に挙げた高次構造による立体効果も得られると考えられる。一般に多糖 類は、分子中に不斉炭素を多く持ち、セルロースのカルバメート誘導体である cellulose trisphenylcarbamate, cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) やアミロースのカルバメート誘 導体である amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) は液体クロマトグラフィー、シクロデキ ストリン誘導体はガスクロマトグラフィーのそれぞれ不斉分割用カラム充填剤として使われ ており、その高次構造が不斉認識に有用であるといった利点が挙げられる。¹⁴⁾その他に、 単糖類を配位子とした金属錯体による医薬品の合成や、アミノ糖を配位子とする [PtCl₂(GlcNN)], [PtCl₂(MeGlcNN)], [PtCl₂(ManNN)] といった錯体を医薬品として生体内で利 用する研究なども行われており、不斉反応への利用も有効である。³⁰⁾

高分子錯体を不斉反応の触媒として用いることにより、不斉が得られる要因として、錯体

の C₂ 対称なフェニル基の立体構造による不斉の誘導以外に、高分子の高次構造による不斉 の誘導が期待され、この高分子構造を制御することにより高い選択性を得ることができると 考えられる。実際に、高分子錯体溶液の pH を変えることによりその高次構造をランダム コイルからα-ヘリックスに変化させ、不斉選択性を変化させるという報告 や、³¹⁾液体クロ マトグラフィーのカラム充填剤であるセルロース誘導体において、高い光学分割能をもつも のは液晶性を示し、低いものは液晶性を示さないことから、高い光学分割能をもつものは規 則的な構造を取っていると考えられる、という報告がなされている。^{14,32)} その他にも、セ ルロースのフェニルカルバメート誘導体では、特定波長の光により構造の一部がシス体また はトランス体へと変化し、光学分割能が変化することも報告されている。³³⁾

高分子錯体の合成にあたっては、次のような方法が挙げられる。

・最初に低分子錯体を合成し、これを重合させて高分子錯体とする

・高分子を合成、配位基を導入し高分子配位子として用い、錯体を合成する

典型的な調製法は、後者であり²⁴⁾、今回は、錯体配位子の前駆体として多糖類を用いる ことから、後者の中でも、高分子を合成せず、すでに存在する高分子を用いる方法をとる。 また、多糖類は一般に水酸基などの官能基を多く持つことから、配位子の合成、誘導体化が 容易であり、この点からも後者の方法が有効であると考えられる。

アミノ多糖類であるキトサンは、天然に多く産出するキチンという高分子を脱アセチル化 したものであり、キチンはセルロース分子の2位の炭素上のOH基が全てNHCOCH3基 で置換されたものである。キチンの脱アセチル化度により、生成するキトサンの溶解性が変 化することが報告されており、脱アセチル化部位をランダムに50%程度行うと、水溶性キ トサンが得られるが、その他の脱アセチル化度では水に可溶なものは得られず、その他の溶 媒に対しても難溶性である。(Figure 2)よって、脱アセチル化度の高いキトサンを配位子 合成に用いる場合、溶媒に可溶な誘導体を合成する必要がある。^{17,34,35)}

本研究では、アミノ多糖類であるキトサンからフタロイル化を行い、これを用いて高分 子配位子 N-Chito-OP 及び N-Chito-P を合成し、均一系触媒として N-Chito-OP を配位子と する Rh 錯体を合成、不均一系触媒としてこれを NaHT ヘインターカレートした Rh-Chito⁺/NaHT を調製した。これらの錯体を用いて水素化反応を行い、層間への固定化による 選択性の変化などについて検討した。

3. 結果と考察

3.1. 糖誘導体のキャラクタリゼーション

3.1.1. Chito-OP のキャラクタリゼーション

水溶性の water soluble chitosan から合成した配位子 Chito-OP のキャラクタリゼーション を行った。Figure 3 と Table 1 に IR スペクトルとその帰属 ³⁶⁾を示した。water soluble chitosan に由来するvC-H(-CH₂-)、vC-O-C などのピークが見られ、それに加えホスファイト 基に由来する vC-H(=CH-)、vP-C 、vP-O-C などのピークが現れており、vO-H によるピー クが減少していることなどから配位子が合成されていると考えられる。

次に合成に用いた water soluble chitosan の元素分析の結果を Table 2 に示す。表の上段に示した計算値は脱アセチル化度が 50% である場合の値である。使用した water soluble

chitosan は chitin をランダムに 50 % 程度脱アセチル化したものであり、水溶性であるには 50 % にかなり近い値でなければならない。しかし、その計算値と測定値はかなり異なって おり、その原因として、水溶性キトサンが吸湿性を持ち、元素分析測定時にかなりの水分が 含まれ、誤差が大きくなると考えられる。そこで、水分量を考慮に入れて計算を行ったが、水分 50 %, chitosan 36 - 40 %, chitin 13 - 8 % という値になり、脱アセチル化度が 80 % と算 出される。その値は 50 % とはかなり差があり、用いた water soluble chitosan が植物培養用 であるためか、脱アセチル化時の不純物がかなり含まれていると考えられる。

よって、この値をもとに算出した、 Chito-OP の元素分析の計算値は、測定値と大きく異なる可能性がある。

次に合成した Chito-OP の元素分析の結果を Table 3 に示す。元素分析の結果から、C/N 比を求めると、その値は C/N=72 であり、計算値の C/N=30 とはかなり差がある。 これは 合成した Chito-OP に不純物であるホスフィン酸が含まれていること、用いた water soluble chitosan に不純物が含まれていためであることなどが考えられる。

3.1.2. N-Chito のキャラクタリゼーション

water soluble chitosan を用いた場合、収率が低く、また副生成物である ホスフィン酸の 分離、精製が困難である。収率の低さの原因として、water soluble chitosan を使用したこと、 また、合成反応を不均一系で行っていたことなどが考えられる。そこで、脱アセチル化度の 高い chitosan 500 を用い、これをフタロイル化することにより有機溶媒に可溶な N-Chito を得た。

まず、用いた chitosan 500 の元素分析結果を Table 4 に示す。Table 4 に示した計算値は、 脱アセチル化度が 100 % の場合のものである。元素分析の結果から脱アセチル化度を算出 すると 80 % 程度であり、これに含まれる水分は 9.5 % 程度である。この値は chitosan 500 の規格とほぼ一致し、また、水分量についても TG の結果と一致する。これから合成した N-Chito の元素分析の計算値を算出した。

また、chitosan 500 の分子量について、キトサン水溶液の粘度からその分子量を算出した。 文献の粘度-分子量データ¹⁷⁾から作成したグラフを Figure 4 に示した。これと chitosan 500 の規格に表示されている粘度が 300 - 700 cP であることから、分子量は 26000 - 29000 であ ると推定される。

次に、chitosan 500 から合成した N-Chito のキャラクタリゼーションを行い、Figure 5 と Table 5 に IR スペクトルとその帰属を示した。chitosan 500 に由来するvC-H (-CH₂-)、 vC-O-C などのピークが見られ、それに加え vC-H (=CH-)、vCO-N 、 δ C-H などのピークが現れており、また、Nishimura らの報告³⁷⁾ と一致しており、N-Chito が合成されていると考えられる。

次に N-Chito の元素分析の結果を Table 6 に示す。

元素分析の結果からも、その計算値と測定値はほぼ等しい値であることから、N Chito が 合成されていると考えられる。

3.1.3. N-Chito-OP のキャラクタリゼーション

N-Chito から合成した配位子 N-Chito-OP のキャラクタリゼーションを行った。Figure 5 と Table 7 に IR スペクトルとその帰属を示した。N-Chito に由来するvC-H(CH₂-)、vCO-N などのピークが見られ、それに加え vP-C、vP-O-C などのピークが現れており、vC-H(=CH-)のピークが増大し、vO-H によるピークが減少していることなどから、N-Chito-OP が合成されていると考えられる。

次に N-Chito の元素分析の結果を Table 8 に示す。表中の計算値はホスファイト基が二 置換である場合の値である。H, N の値に関してはほぼ同じであるが、C に関しては測定値 の方が低い値である。これはホスファイト基の修飾量が低いためであると考えられる。よっ て、元素分析の結果から C/N 比を求め、計算値と比較すると、キトサンユニット 1 に対 しホスファイト基が 1.6 修飾されていると考えられる。以上の結果より、N-Chito-OP が合 成されていると考えられる。

3.1.4. N-Chito-OTs のキャラクタリゼーション

N-Chito から合成した配位子前駆体 N-Chito-OTs のキャラクタリゼーションを行った。 Figure 6 と Table 9 に IR スペクトルとその帰属を示した。 N-Chito に由来する vC-H (-CH₂-)、vCO-N などのピークが見られ、それに加えトシル基による vSO₂ のピークが現れて いることから、N-Chito-OTs が合成されていると考えられる。

しかし、水酸基による vO-H のピークがあまり減少していないことから、トシル化は一 置換のみされていると考えられる。

次に、元素分析結果を Table 10 に示す。表中の計算値は一置換体の場合の計算値である。 元素分析の結果は、計算値と測定値がほぼ等しく、この結果からも得られた N-Chito-OTs が一置換体であると推測される。

3.1.5. N-Chito-P のキャラクタリゼーション

N-Chito-OTs から合成した配位子 N-Chito-P のキャラクタリゼーションを行った。Figure 6 と Table 11 に IR スペクトルとその帰属を示した。N-Chito-OTs に由来する vC-H (- CH₂-)、vCO-N などのピークが見られ、トシル基による vSO₂ のピークが消失し、さらに vP-C のピークが現れていることから、N-Chito-P が合成されていると考えられる。

しかし、その収量は極僅かであり、配位子として用いることが可能な量は得られなかった。 よって、次段階の錯体合成は N-Chito-OP を用いて行った。

3.2. 均一系触媒のキャラクタリゼーション及び立体構造の検討

3.2.1. $[Rh(COD)Cl]_2$ のキャラクタリゼーション

配位子前駆体である [Rh(COD)Cl]₂ を合成し、Figure 7 と Table 12 に IR スペクトルと その帰属を示した。vC-H, v_{as}C-H, vC=C などのピークが見られ、文献³⁸⁾ とも一致すること から、[Rh(COD)Cl]₂ が合成されていると考えられる。

3.2.2. Rh-Chito のキャラクタリゼーション及び立体構造の検討

N-Chito-OP, [Rh(COD)Cl]2 から合成した錯体のキャラクタリゼーションを行った。Figure

7 と Table 13 に IR スペクトルとその帰属を示した。N-Chito-OP に由来する vC H (-CH₂-)、 vCO-N、vP-C 、vP-O-C などのピークが見られ、また、vP-O-C によるピークがシフトして いることから、錯体が合成されていると考えられる。

合成した錯体中の Rh 量を推定するため、Rh-Chito 合成後のろ液を回収、配位子と分離 後、Rh(COD)ClO₄・S (S: solvent) と考えられるろ液全てを DMSO 25 ml に溶かし、この溶 液の UV 測定を行った。Figure 8 に既知サンプルにより得られた検量線、Figure 9 に回収し たサンプルの UV-vis スペクトルを示す。CT 遷移によるピークと考えられる 429 nm での absorbance とその検量線から、このろ液に含まれる Rh 量は 0.23 mmol と算出でき、合成 した錯体 (0.73 g) に含まれる Rh 量は 0.82 mmol であると考えられる。これから、触媒反 応に使用する Rh 錯体量 (6.25*10⁶ mol) は 0.0056 g と算出した。

その構造は、元素分析の結果から、Chito-OP に修飾されたホスファイト基が、1 ユニ ットにつき 1.6 であり、Rh に対し、ホスファイト基が配位しやすいことから、2 座配位を 形成しているものと考えられる。また、Figure 10 に示したキトサンの構造から考えると、 キトサン 1 ユニット内での 2 座配位は困難であると考えられる。これらのことから、 Figure 11 の様に、キトサン 2 ユニット間で 2 座配位しているものと考えられる。

3.3. Rh-Chito⁺/NaHT の構造解析と層間でのゲストの立体構造

Rh-Chito, NaHT から調製した Rh-Chito⁺/NaHT のキャラクタリゼーションを行った。 Figure 12 と Table 14 に IR スペクトルとその帰属を示した。NaHT に由来するピークに加 え、Rh-Chito に由来する vC-H (-CH₂-)、vC-O-C などのピークが見られ、また、ClO₄ によ るピークが消失していることから、ヘクトライト層間内に錯体がインターカレートされてい るものと考えられる。

Figure 13 と Table 15 に NaHT, Rh-Chito⁺/NaHT の XRD パターンとそのパラメータを示した。クリアランススペースが 0.28 nm から1.06 nm へと拡大していることから、ヘクトライト層間内に錯体がインターカレートされていると考えられる。

調製した Rh-Chito⁺/NaHT の TEM 像 を Figure 14 に示した。これをみると、層間隔が 1.7 nm に拡大しており、その層構造が数十 nm にわたって保持されていることが確認でき た。この値は XRD の結果である 2.02 nm より小さい値となっているが、これは、TEM 測定時の高真空状態により、XRD 測定時にはヘクトライト層間内に残存していた DMF 溶 媒がなくなり、層間隔が狭まったためであると考えられる。また、TEM 像から底面間隔を 計測する際、層構造の境界がはっきりしないため、これによる底面間隔の測定誤差も考えら れる。

EDS 測定により、この構造物から Rh, P, Si, Mg などの元素が検出されており、Clは検出 されなかったことから、カチオン交換により、錯体が粘土鉱物にインターカレートされてい るものと考えられる。なお、EDS 測定結果のピーク強度から求めた、各元素のモル比は理 論値とは一致していないが、ビームの照射方向がヘクトライトのシリケート層に対し垂直方 向であるか、水平方向であるかにより、ピーク強度が変わってくると考えられ、定量性につ いては特に述べられない。

次に Rh-Chito⁺/NaHT の元素分析の結果を Table 16,17 に示す。この結果から、粘土鉱物

10

層間へインターカレートされた錯体量を算出した。Table 16 の計算値はカチオン交換率が 100% である時の値であり、これと測定値を比較すると、粘土鉱物層間への錯体のカチオン 交換率は 40% であり、担持量は 34.6 meq/100g-NaHT であると考えられる。よって触媒反応 1 回あたりに使用する Rh-Chito⁺/NaHT の重量は 0.0183 g (6.25*10⁻⁶ mol-Rh)と算出でき た。

以上の結果から、調製した不均一系触媒 Rh-Chito⁺/NaHT の構造について検討した。まず、 高分子配位子の原料として用いたキトサンの構造については、 Figure 10 に示すように、2/1 及び 8/3 らせん構造などが考えられる。2/1 らせん構造に比べ、8/3 らせん構造はその幅が 厚く、粘土鉱物の層間隔と一致しない。2/1 らせん構造をとると、得られた配位子のモデル の厚さは 1 nm 程度であると考えられ、XRD の結果の 1.06 nm と良く一致する。よってへ クトライトの層間内に 2/1 らせん構造を持つ錯体の一分子層が形成されており、キトサン 分子鎖は Figure 15 に示すように、ヘクトライトのシリケート層に対してほぼ平行に配向し ていると考えられる。

3.4. 触媒反応

3.4.1. イタコン酸ジエステルの不斉水素化反応

均一系触媒として Rh-Chito 、不均一系触媒として Rh-Chito⁺/NaHT を用い、反応基質と してプロキラルなイタコン酸エステルの不斉水素化反応を行った。反応基質としてイタコン 酸エステルを用いる利点としては以下のようなものが挙げられる。

- ・オレフィンの水素化により光学異性体が生成する
- エステル基を容易に置換でき、様々な誘導体が合成できる
- ・エステル基の分子サイズを変化でき、かさ高さの影響を調べられる
- ・エステル基に極性基などを導入することにより、その影響を調べられる
- ・光学異性体、分子サイズ、官能基などの分子の性質を同時に調べられる
- (多重認識性)

反応基質としてイタコン酸エステルを用いた場合、水素化反応は Scheme 1 に示すような 経路で進行するものと考えられる。

均一系及び不均一系触媒を用いた反応での、イタコン酸エステルとその生成物の反応挙動 (反応初速度、選択性など)の各条件での変化について以下に示す。

3.4.1.1. 均一系、不均一系触媒による不斉水素化反応挙動

反応溶媒に MeOH, DMSO, DMF, MeOH/DMF=1, MeOH/DMF=30 などを用いた。均一系 触媒及び不均一系触媒を用い、反応基質として、反応速度が最も速いと考えられる、直鎖状 エステル基が dimethyl (C₁) のものを主に用いて反応を行い、一部dibutyl (C₄) についても反 応を行った。反応結果 (conversion curve と不斉選択性の経時変化)を Figure 16-23 に示し た。これらの conversion curve において、●は反応基質、□は水素化生成物の R 体、■は 水素化生成物の S 体、〇はオレフィン異性体のメサコン酸エステルを示す。

まず、反応溶媒に MeOH を用いた場合、Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT ともに溶媒に溶解せず、反応はほとんど進行しなかった。よって、反応溶媒として、Rh-Chito とより親和性の

高い DMSO, DMF をもちいて反応を行った。

DMSO を用いた場合には、その反応速度は非常に遅く、不斉選択性を求めるまでに至ら なかった。これについては、高分子錯体を触媒として用いた不斉水素化反応で、反応溶媒と して DMSO を用いた場合、反応活性が落ちることが報告されている。³⁹⁾

次に、DMF を用いた場合の反応結果を Figure 16 に示した。これについては反応基質と して dibutyl itaconate (C₄)を用いた。これを見ると反応基質が消失するとともに水素化生成 物が徐々に生成することが分かる。また、オレフィン異性体のメサコン酸エステル

(mesaconate) が 5% 程度生成している。また、もう一方のオレフィン異性体であるシト ラコン酸エステル (citraconate) は生成しなかった。しかし、基質が 50% 程度反応した時 点で反応が停止し、その時点で R, S 体の生成比はほぼ等しく、不斉選択性は 1.6% e.e. (S) と、ほとんど不斉選択性は得られていない。

よって、反応溶媒として alcohol/DMF 混合溶媒を用い、alcohol の種類、及びその比率を 変化させて反応を行い、その結果を Figure 17 - 23 に示した。これらの Figure を見ると、全 ての反応において、主生成物として R 体が得られており、 Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT では、 錯体と基質との配位構造が R 体生成に有利な構造をもっていると考えられる。反応の結果 をTable 18 にまとめて示した。

3.4.1.2. 触媒反応における不斉選択性の溶媒依存性

反応溶媒による均一系、不均一系触媒の不斉選択性の変化を Figure 24 に示した。これを 見ると、DMF 濃度を低下させると均一系、不均一系ともに選択性の向上が見られた。これ について次のように考察した。

Halpern らによる不斉水素化反応のメカニズム⁴⁰⁻⁴³⁾ に基づいて考えると、活性種である $[Rh(P-P^*)S_2]^{\dagger}$ から溶媒が脱離し、空いた d 軌道に反応基質がオレフィンと β -カルボニル とでキレート配位する段階は非常に速い平衡反応であり、このキレート配位した中間体が水 素化生成物の立体配置を決定する。極性の高い溶媒ほど配位力は強く、活性種からの溶媒の 脱離が困難となり、基質が錯体にキレート配位しにくくなると考えられる。反応物として C=O 水素化生成物が見られず、また、反応基質の C=O 基に対する溶媒和が考えられるこ とから、錯体と C=O 基との配位が弱まり、錯体と C=C 基との単座配位で水素化が進行す ると推測される。(Figure 25)

よって、極性の高い DMF 溶媒では、反応基質のキレート配位が困難となり、単座配位で 反応が進行するため、選択性が低下すると考えられ、DMF 濃度を低下させることにより、 Rh 錯体への DMF の配位を弱めると、錯体と基質とのキレート配位が容易となり、選択性 が向上するものと考えられる。

3.4.1.3. 触媒反応における不斉選択性の均一系反応と不均一系反応の比較

均一系触媒と不均一系触媒の比較を行うと、均一系に比べ、不均一系ではTurn Over は落ちているものの、不斉選択性については各条件とも向上が見られた。

この点について、次のように考察した。

不斉ジホスフィン系ロジウム錯体による itaconate の不斉水素化反応の反応機構は Figure

26 のような経路で進行し、反応基質の錯体への配位は平衡反応、水素の酸化的付加が律速 段階であり、水素移動、還元脱離が速度支配であることが Halpern らにより明らかにされ ている。不斉の発現は、錯体と基質とが配位した反応中間体である Pro-*R*, Pro-*S*の安定性 によることが分かっている。⁴⁰⁻⁴³⁾

この二つの中間体の安定性は、錯体の、 C₂ 対称な 4 つのフェニル基のフェイス面、エ ッジ面と反応基質との相互作用に起因する。つまり、錯体に反応基質が配位する際、反応基 質とフェニル基のフェイス面とが強く反発するのに対し、エッジ面との反発は弱く、これに より基質の配向(エナンチオ面)が決定し、水素化される方向が決定する。

つまり、Figure 27^{13,44)} に示したような、C₂ 対称な構造を持つ、フェニル基のフェイス・ エッジ面がリジッドな錯体を用いると高い不斉選択性が得られると考えられる。

よって、Rh-Chito に比べ、Rh-Chito⁺/NaHT の方が選択性が向上している点については、 次のように推測される。Figure 28 に示すように、高分子配位子からなるRh-Chito は反応溶 媒中で比較的自由な conformation をもち、フェニル基のフェイス・エッジ面の C₂ 対称性 が崩れて、錯体と反応基質との相互作用が弱まり、選択性が低いのに対し、Rh-Chito⁺/NaHT では、3.3. で考察したように(Figure 15)層間へのインターカレーションによりその構造が 規制され、フェイス・エッジ面の C₂ 対称性がよくなり、錯体と基質との相互作用が強めら れることにより選択性が向上するものと考えられる。

選択性の絶対値自体は低分子ホスフィン配位子のものより低くなっている。これは、高分子配位子であることから、低分子配位子より均一性に劣り、フェニル基のフェイス・エッジ 構造による C₂ 対称性の均一性が低下しているためと考えられる。

3.4.1.4. 触媒反応における不斉選択性と錯体の旋光度との関係

触媒反応において得られた不斉選択性は他の低分子ホスフィン錯体に比べて低いものであ り、その原因としては、錯体自体の構造に問題があることも考えられる。よって、合成した 配位子及び錯体の旋光度について検討した。キトサン、配位子、錯体の旋光度を Table 19 に示した。これをみると、錯体 (Rh-Chito)の旋光度は、合成した配位子、また代表的な高 選択性を示すホスフィン錯体である [Rh((*R*,*R*)-norphos)(NBD)]ClO₄ に比べて低い。旋光度と 不斉選択性とは直接比較はできないが、[Rh ((*S*,*S*)-DIOP)(COD)]ClO₄ や [Rh((*R*,*R*)-norphos)-(NBD)]ClO₄といった、高い不斉選択性が得られる錯体に比べると Rh-Chito の旋光度は小さ い⁴⁵⁾ また、低分子不斉ホスフィン Rh 錯体では、不斉配位子単独の旋光度より、大きく増 加することが知られている。⁴⁵⁾ 例えば (*R*,*R*) norphos で [α] λ が -44° (λ =578 nm) か ら -105° (λ =589 nm) へと増加している。これらのことから、Rh-Chito は効果的にキレ ート配位が行われていない可能性がある。よって、不斉選択性を高めるには、配位子合成、 錯体合成段階で高い旋光度を得るための分子設計が重要である。

N-Chito-OP の前駆体である chitosan 500 は測定に適当な、可溶な溶媒が無いため、旋光 度測定が困難であった。参考として water soluble chitosan の旋光度を測定したが、その値は -8°であり、回転方向が逆転しているものの、高い値ではなかった。よって、キトサンが、 高い不斉選択性を得るための配位子材料としてはあまり良いものではないことも考えられる。 不斉水素化反応では、Rh-Chito を NaHT ヘインターカレートすることにより高次構造を 規制し、選択性が向上したと考えられる。これは C₂ 対称をとるという点ではよいが、液体 クロマトグラフィーなどで不斉誘導の源となっている高分子の高次構造¹⁷⁾をうまく利用で きていないことになり、この高次構造を錯体の構造に活用できれば、さらに高い不斉選択性 を得ることができると考えられる。

3.4.2. geraniol の部分水素化反応

他の基質として、プロキラルな物質である geraniol の水素化反応を行った。その反応は Scheme 2 に示すような経路で進行するものと考えられる。

この反応の比較、参照として [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆を用いて均一系での水素化反応を行った結果に基づき、均一系触媒を用いた反応での、geraniol と反応生成物の反応挙動について以下に示す。

3.4.2.1. 均一系触媒による水素化反応挙動

反応溶媒に MeOH 溶媒を用いた。参照触媒である [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ を用い、反応基 質である geraniol の水素化反応を行った。反応結果 (conversion curve) を Figure 29 に示し た。これらの conversion curve において、●は反応基質、□は部分水素化生成物の citronellol、■はもう一方の水素化生成物の 3,7-dimethyl-2-octen-1-ol、〇は最終水素化生成物 である 3,7-dimethyl-1-octanol を示す。

参照触媒である $[Rh(PPh_3)_2(COD)]PF_6$ では反応基質が徐々に消失するとともに、水素化生成物である citronellol 及び 3,7-dimethyl-1-octen-2-ol が生成した。しかし、均一系触媒として、Rh-Chito を用いた場合には 303 K, 313 K, 323 K 全ての反応温度において反応の進行が認められなかった。

itaconate の不斉水素化反応において、[Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆を用いた場合数時間で反応が 終了するのに対し、Rh-Chitoを用いた場合には数百から数千時間を要する。geraniolの水素 化反応において [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆を用いた場合でも反応終了までに数十時間を要してい ることから、Rh-Chito ではさらに時間が必要であると推測され、この基質を用いた触媒反 応については、水素高圧条件下での反応が望ましいと考えられる。

3.4.3. citronellal の部分水素化反応

反応基質として geraniol を用いた場合は、水素化反応はほとんど進行しなかった。よって 次に、geraniol と同じテルペン類である citronellal を用いて水素化反応を行った。通常、疎 水性の配位子を持つホスフィン - ロジウム錯体は C=C に対してより活性を示す。キトサ ンのような親水性基の配位子は比較的 C=O 基と親和性があることから、Rh-Chito は C=O に対する高活性が期待される。citronellal は一分子内に C=O 基と C=C 基とを持つ化合物 であり、この反応を行うことにより、これら二つの官能基の水素化選択性が検討できる。ま た、錯体配位子としてキトサンを用いていることから、配位子としてトリフェニルホスフィ ン基をもつ [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ とは異なる反応挙動が期待できる。反応は Scheme 3 に示 すような経路で進行するものと考えられる。

この反応の比較、参照として [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ を用いて均一系での水素化反応を行っ

た結果に基づき、均一系及び不均一系触媒を用いた反応での、citronellal と反応生成物の反応挙動(反応初速度、官能基選択性等)の各条件での変化について以下に示す。

3.4.3.1. 均一系、不均一系触媒による水素化反応挙動

反応溶媒に MeOH, MeOH/DMF=1 溶媒を用い、参照触媒である [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆, Rh-Chito, Rh-Chito+/NaHT を用い、反応基質である citronellal の水素化反応を行った。反応結果 (conversion curve) を Figure 30 - 32 に示した。これらの conversion curve において、●は 反応基質、□は C=O 基水素化生成物の citronellol、■は C=C 基水素化生成物の 3,7dimethyl-1-octanal、○は最終水素化生成物である 3,7 dimethyl-1-octanol を示す。

[Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ を用いた場合、octanal が主に生成し、citronellol はほとんど生成しない。 (反応開始後 6 h で citronellal が 90 % 反応し、octanal が 87 %、citronellol が 2 % 生成)

Rh-Chito を用いた場合では初期に octanal が急激に生成するが、その後停止し、 citronellol のみゆっくりと生成している。(反応開始後 2260 h で citronellal が 90% 反応し、 octanal が 33%、citronellol が 58% 生成)

Rh-Chito⁺/NaHT を用いた場合、その傾向は Rh-Chito の場合とあまり変わらず、octanal が 急激に生成し、citronellol はあとからゆっくり生成している。(反応開始後 1674 h で citronellal が 86 % 反応し、octanal が 42 %、citronellol が 44 % 生成)

反応の結果をTable 20 にまとめた。

3.4.3.2. Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT と [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ (参照触媒)との触媒反応挙動の比較

反応の主生成物は、[Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ を用いた場合は octanal であり、 Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT を用いた場合は citronellol である。

このような差があらわれる原因としては、[Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆は配位子として疎水性の ホスフィン基を持つのに対し、Rh-Chito 及び Rh-Chito⁺/NaHT では、配位子として親水性の glucose 環を持つ糖類を用いていることから、基質の C=O 基とより強く相互作用するため と考えられる。また、かさ高い配位子を用いることにより、内部オレフィンを水素化しにく いといった、立体障害による反応性の変化があらわれていることも考えられる。

また、反応の経時変化についてだが、[Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ を用いた場合、octanal のみ生成し、Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT を用いた場合ではともに、octanal が初期に急激に生成し、 citronellol はゆっくりと生成するという傾向がみられた。このような挙動を示す原因として、 Rh-Chito 及び Rh-Chito⁺/NaHT に 2 種の錯体が含まれている可能性が考えられる。配位子 である N-Chito-OP と Rh が二座配位している錯体と、これとは別に、Rh に配位子が配位 していないか、もしくは単座配位している Rh 錯体が存在し、単座配位の錯体では、 [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ の場合と同様に、錯体と基質との立体障害が少ないために octanal が 生成し、一方、二座配位している錯体では、基質と錯体との立体障害が大きいために、ゆっ くりと citronellol が生成していると考えられる。(Figure 33)

15

3.4.3.3. 触媒反応における反応挙動の均一系反応と不均一系反応の比較

均一系反応と不均一系反応の結果では、不均一系の反応途中までは octanal が初期に急激 に生成し、citronellol はゆっくりと生成するという傾向が見られたが、不均一系では、反応 途中で急激に反応が進行し、citronellol, octanal がともに生成している。

反応の水素化選択性については、均一系において、不均一系に比べて高い C=O 水素化選択性が得られた。この原因としては、錯体がヘクトライト層間内にあることにより、配位子であるキトサン誘導体の glucose 環の平面がヘクトライトシリケート層により覆われ、均一系反応に比べ、基質の C=O 基との相互作用が弱まるためであると考えられる。また、ヘクトライト層間内で錯体の二座配位がくずれ、単座配位の錯体が増加し、C=C 水素化選択性が向上した可能性も考えられる。(Figure 34)ただし、反応は現在進行中であり、C=O 水素化選択性が向上する可能性はある。

各触媒での citronellol 生成の初速度を比較すると、Rh-Chito では $5.8*10^{-3}$ mol mol-Rh⁻¹ h⁻¹、Rh-Chito⁺/NaHT では $5.0*10^{-3}$ mol mol-Rh⁻¹ h⁻¹ と、生成速度が多少遅くなっている。また、octanal の生成初速度に関してはほとんど変化がみられず、初速度に関しては両者に著しい違いは見られない。

なお、不均一系反応に見られた急激な反応進行に関しては、反応恒温槽の温度の急激な変化などの外的要因が考えられ、これにより C=C 及び C=O がともに水素化され、C=O, C=C 選択性が低下した可能性が考えられる。

4. 総括

4.1. 層間固定化錯体の合成およびその構造

Chito-OP の合成に関しては、FT-IR 及び元素分析の結果より、合成できたと考えられるが、 最終的に収率は 45% 程度であった。

N-Chito は収率 95%, N-Chito-OP は収率 75% で得られ、これから、Rh-Chito を合成することができた。収率は 70%。

カチオン交換によりヘクトライト層間内に Rh-Chito をインターカレートし、Rh Chito⁺/NaHT を調製した。その底面間隔は 2.02 nm であり、クリアランススペースはは 1.06 nm と推測され、インターカレートが確認された。元素分析結果から、担持量は 36.4 meq/100 g-NaHT であることを確認した。その TEM 像により、数十 nm にわたる層構造の 保持、層間隔の拡大を確認した。この結果と分子モデルから、層間内での錯体の構造につい て検討すると、錯体は 2/1 らせん構造をとり、ヘクトライトのシリケート層に対してキト サン分子鎖がほぼ平行に配向していると考えられる。このように、層構造がキトサン分子鎖 のコンフォメーションを制御していると思われる。

4.2. 触媒反応

4.2.1. itaconate の不斉水素化反応

均一系、不均一系触媒で、ともに、不斉選択性の反応溶媒依存性が見られ、DMF 濃度が 低下すると選択性の向上が見られ、極性溶媒による反応の阻害が原因と推測された。

また、均一系触媒に比べ、不均一系触媒を用いた場合、不斉選択性の向上が見られ、これ

については層間での規制されたゲスト錯体の立体構造(2/1 らせん構造)が関与しているこ とが推測された。従って、層空間で糖鎖のコンフォメーションを制御することにより、選択 性が向上したと考えられる。

4.2.2. citronellal の水素化反応

参照触媒である [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆ では octanal のみ生成したのに対し、Rh-Chito, Rh-Chito⁺/NaHT を用いた場合、citronellol が主に生成し、糖配位子を用いることにより、その 立体構造、化学的性質による特異な挙動が示された。均一系、不均一系反応の差については、 顕著な差が見られず、この系での触媒挙動はキトサン主鎖が支配的であると考えられる。

5. 参考文献

- 1) T. J. Pinnavaia, A. C. S. Symposium Series, 192, 241-253 (1982).
- 2) M. Mazzei, W. Marconi and M. Riocci, J. Mol. Catal., 9, 381-387 (1980).
- G. Cao, M. E. Garcia, M. Alcala, L. F. Burgess and T. E. Mallouk, J. Am. Chem. Soc., 114, 7574-7575 (1992).
- 4) 仙頭準,"千葉大学修士論文(工業物理化学講座)",(1995).
- S. Shimazu, K. Ro, T. Sento, N. Ichikuni and T. Uematsu, J. Mol. Catal. A, 107, 297 303 (1996).
- 6) S. Shimazu and T. Uematsu, J. Synth. Org. Chem., 51, 664-670 (1993).
- 7) T. P. Dang and H. B. Kagan, J. Am. Chem. Soc., 94, 6429-6433 (1972).
- 8) 村橋俊一,山本明夫,野依良治編," 化学增刊 124 号",化学同人,167-196 (1995).
- 9) 村橋俊一,山本明夫,野依良治編, ibid., 203-218 (1995).
- 10) J. T. Groves and P. Viski, J. Am. Chem. Soc., 111, 8537 (1989).
- 11) H. Sasaki, R. Irie, T. Hamada, K. Suzuki and T. Katsuki, Tetrahedron, 50, 11827 (1994).
- H. Becker, P. T. Ho, H. Kolb, S. Loren, P.- O. Norrby and K. B. Sharpless, *Tetrahedron Lett.*, 35, 7315 (1994).
- 13) 尾島巌, 小暮哲夫, "化学総説 No. 34", 学会出版センター, 162-175 (1982).
- 14) 岡本佳男, 海田由里子, 有機合成化学協会誌, 51, 59-71 (1993).
- 15) Y. Okamoto, R. Aburatani, Y. Kaida and K. Hatada, Chem. Lett., 1125-1128 (1988).
- 16) Y. Okamoto, Z.- K. Cao, R. Aburatani and K. Hatada, Bull. Chem. Soc. Jpn., 60, 3999 4003 (1987).
- 17) キチン、キトサン研究会編, "*キチン、キトサンハンドブック*", 技報堂出版, 227-231 (1995).
- 18) 白水晴雄," 粘土鉱物学",朝倉書店, (1988).
- 19) 鳥居一雄, 表面, 27, 349-359 (1989).
- 20) K. Kaneda, M. Terasawa, T. Imanaka and S. Teranishi, Chem. Lett., 1005-1008 (1975).
- 21) 今中利信, 金田清臣, "*化学総説 No. 34*", 学会出版センター, 176-189 (1982).
- 22) T. J. Pinnavaia, R. Rathatha, J. G. Lee, L. J. Halloran and J. F. Hoffman, J. Am. Chem. Soc., 101, 6891-6897 (1979).

- 23) H. Takaya, K. Mashima, K. Koyano, M. Yagi, H. Kumobayashi, T. Taketomi, S. Akutagawa and R. Noyori, J. Org. Chem., 51, 629-635 (1986).
- 24) 平井英史, 戸嶋直樹編, "高分子錯体触媒", 高分子学会出版センター, 6-7 (1982).
- 25) T. H. Kim and H. F. Rase, Ind. Eng. Chem., Prod. Res. Dev., 15, 249-254 (1976).
- 26) W. Dumont, J.- C. Poulin, T.- P. Dang and H. B. Kagan, J. Am. Chem. Soc., 95, 8295 8299 (1973).
- 27) R. H. Grubbs and E. M. Sweet, Macromolecules, 8, 241-242 (1975).
- 28) K. Achiwa, Chem. Lett., 905-908 (1978).
- 29) F. H. Jardine and G. Wilkinson, J. Chem. Soc. (C), 270-271 (1967).
- 30) 渡部正利, 矢野重信, 碇屋隆雄, "ウェルナー錯体と有機金属錯体", 講談社サイエンティフィク, 190-193 (1991).
- 31) 平井英史, 触媒, 15, 117-125 (1973).
- 32) U. Vogt and P. Zugenmaier, Makromol. Chem. Rapid. Commun., 4, 759-765 (1983).
- 33) Y. Okamoto, H. Sakamoto and K. Hatada, Chem. Lett., 983-986 (1986).
- 34) T. Sannan, K. Kurita and Y. Iwakura, Makromol. Chem., 176, 1191-1195 (1975).
- 35) K. Kurita, T. Sannan and Y. Iwakura, *ibid.*, 178, 3197-3202 (1977).
- 36) 中西香爾, P. H. ソロモン, 古舘信生 共著, "赤外線吸収スペクトル -定性と演習-(改訂版)",南江堂, (1978).
- 37) S. Nishimura, O. Kohgo, K. Kurita, C. Vittavatvong and H. Kuzuhara, *Chem. Lett.*, 243 246 (1990).
- 38) Tanaka and I. Ogata, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 735 (1975).
- 39) Nakamura and H. Hirai, Chem. Lett., 645-650 (1974).
- 40) Landis and J. Halpern, J. Am. Chem. Soc., 109, 1746-1754 (1987).
- 41) C. Chan, J. J. Pluth and J. Halpern, J. Am. Chem. Soc., 102, 5952-5954 (1980).
- 42) Ojima, T. Kogure and N. Yoda, J. Org. Chem., 45, 4728-4739 (1980).
- 43) Brown and P. A. Chaloner, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 344-346 (1980).
- 44) 碇屋隆雄, 橋口晶平, 宮竹達也, 香月昂, 野崎良治, 日*経サイエンス 11 月号*, 25 (1994).
- 45) Kyba, R. E. Davis, P. N. Juri and K. R. Shirley, Inorg. Chem., 20, 3616-3623 (1981).

			way	venumber /	cm		
sample	$v_{\text{O-H}}$	v _{с-н} (=СН-)	∨ _{asC-H} (-CH ₂ -)	v_{c-o-c}	$\mathbf{v}_{\mathtt{P-C}}$	v _{P-O-}	C
chitosan	3413	an a	2929	1136	and a second		n de la compania de l
Chito-OP	3412	3057	2926	1119	1438	1182, 9	998
Table 2. Ele	emental and	alysis of wa	ter soluble cl	nitosan			
sample	C/%	Η/%	N/%				
calcd	46.0	6.7	7.8				
found	32.1	6.4	4.3				
Table 3. Ele	emental and	alysis of Ch	ito-OP				
sample	C/%	Η/%	N/%				
calcd	63.7	5.4	2.5				
found	67.5	5.7	1.1				
Table 4. Ele	emental an	alysis of chi	tosan 500		-		
sample	C / %	Η/%	N/%	C/N			
calcd	44.7	6.9	8.7	6.0			
found	41.0	7.3	7.5	6.4			
Table 5. At	osorption p	peaks and p	eak assignme	nt of chitos	an 500 and	N-Chito	
				wavenum	$1 \text{ ber} / \text{ cm}^{-1}$		
sample	ν _c	о-н V((=С	C-H V _{asc} CH-) (-CH	_{C-H} ν _{C-0} I ₂ -)	0-c V	'co-n	δ _{с-н} (=CH-)
chitosan 500) 34	39	- 291	9 10	80		

Table 1. Absorption peaks and peak assignment of water soluble chitosan and Chito-OP

2926

1068

1714, 1390

873, 720

N-Chito

۰

3471

3072

Table 6.	Elemental analysis of N-Chito					
sample	C / %	H/%	N/%			
calcd	55.7	4.9	5.2			
found	55.3	4.9	5.5			

Table 7. Absorption peaks and peak assignment of N-Chito and N-Chito-OP

	wavenumber / cm ⁻¹					
sample	$v_{\text{O-H}}$	∨ _{с-н} (=СН-)	ν _{C-H} (-CH ₂ -)	$\nu_{\text{CO-N}}$	v_{P-C}	v_{P-O-C}
N-Chito	3471	3072	2926	1714,1390		
N-Chito-OP	3432	3055	2942	1718,1386	1438	1118, 998

Table 8.	Elemental analysis of N-Chito-OP					
sample	C / %	Η/%	N/%			
calcd	69.2	4.7	2.1			
found	64.5	4.8	2.2			

Table 9. Absorption peaks and peak assignment of N-Chito and N-Chito-OTs

	wavenumber / cm ⁻¹						
sample	$\nu_{\text{O-H}}$	ν _{c-H} (=CH-)	ν _{asC-H} (-CH ₂ -)	v _{C-O-C}	$\nu_{\text{CO-N}}$	$v_{_{SO2}}$	
N-Chito	3471	3072	2926	1068	1714, 1390	anna an ann an Anna an	
N-Chito-OTs	3470	3068	2926	1068	1714, 1390	1177	

Table 10. Elemental analysis of N-Chito-OTs

sample	C/%	H/%	N/%
calcd	56.6	4.3	3.1
found	55.4	4.5	3.4

			wa	venumber	/ cm ⁻¹	
sample	$\nu_{\text{O-H}}$	ν _{с-н} (=СН-)	ν _{asC-H} (-CH ₂ -)	v_{P-C}	$v_{\text{CO-N}}$	$\mathbf{v}_{\mathrm{SO2}}$
N-Chito-OTs	3470	3068	2926	-	1714, 1390	1177
N-Chito-P	3470	3057	2921	1436	1710, 1390	-

Table 11. Absorption peaks and peak assignment of N-Chito-OTs and N-Chito-P

Table 12.	Absorption peaks and peak assignment of [Rh(COD)	$Cl]_2$

	wavenumber / cm^{-1}				
sample	v _{asC-H} (-CH ₂ -)	∨ _{sC-H} (-CH ₂ -)	$v_{C=C}$	δ _{с-н} (=CH-)	
[Rh(COD)Cl] ₂	2936	2873	1468	1423	

Table 13.	Absorption neaks and	neak assignment of N Chito OD and Dh Chita
	1 10001 ption pours and	peak assignment of N-Chito-OF and Kii-Chito

			w	avenumber / cr	n ⁻¹	
sample	v_{o-H}	ν _{с-н} (=CH-)	ν _{C-H} (-CH ₂ -)	$\nu_{\rm CO-N}$	v_{P-C}	$v_{\text{P-O-C}}$
N-Chito-OP	3470	3055	2942	1718, 1386	1438	1118, 998
Rh-Chito	3447	3058	2931	1717, 1388	1438	1122, 995

Table 14. Absorption peaks and peak assignment of Rh-Chito and Rh-Chito⁺/NaHT

	wavenumber / cm ⁻¹				
sample	v _{с-н} (-CH ₂ -)	$\nu_{\text{CO-N}}$	v_{P-C}	v_{ClO4}	$\nu_{\texttt{Si-O}}$
Rh-Chito	2931	1717, 1388	1438	1097	en e
NaHT	-	-	-	-	1010
Rh-Chito ⁺ /NaHT	2924	1717, 1388	1437	-	1010

•

Tuoto To: The parameters of Wall and Kit-Child 7Nall						
sample	20/ degree	d ₀₀₁ / nm	C.S.*/ nm			
NaHT	7.10	1.24	0.28			
Rh-Chito ⁺ /NaHT	4.38	2.02	1.06			

Table 15. XRD parameters of NaHT and Rh-Chito⁺/NaHT

*Clearance space= d_{001} - 0.96 (thickness of silicate layer).

14010 10.	mol ratio / %				
sample	Rh	Р	Si	Mg	
calcd	1.0	2.0	30.3	20.2	
found 1	1.0	0.7	10.9	6.0	
found 2	1.0	1.1	13.8	9.1	
found 3	1.0	2.0	23.4	15.4	

Table 16 The element composition of Rh-Chito⁺/NoUT

Table 1	17	Elemental	analys	is of	Rh-C	hito ⁺ /	NaHT
~~~~		2. outoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutouto	unary S		IUI-O	mu /	TATT

sample	C / %	Η/%	N/%
calcd	43.0	3.0	1.5
found	25.7	2.5	1.3

catalyst	solvents	initial rate / mol h ⁻¹ mol-Rh ⁻¹	reaction time / h	yield/ _. %	e.e. (R) / %
Rh-Chito	MeOH/DMF=1	1.4	402	99	5.5
Rh-Chito	MeOH/DMF=30	$3.0 \times 10^{-1}$	90	61	6.3
Rh-Chito	EtOH/DMF=1	1.9x10 ⁻¹	960	75	2.9
Rh-Chito	EtOH/DMF=30	$3.4 \times 10^{-2}$	574	69	7.7
Rh-Chito	MeOH	$4.3 \times 10^{-2}$	50	3	3.5 ^{a)}
Rh-Chito (C ₄ )	DMF(313 K)	2.6	122	50	-1.6 ^{b)}
Rh-Chito ⁺ /NaHT	MeOH/DMF=30	$2.2 \times 10^{-1}$	165	48	14.0
Rh-Chito ⁺ /NaHT	EtOH/DMF=1	6.9x10 ⁻¹	72	47	7.7
Rh-Chito ⁺ /NaHT	EtOH/DMF=30	$1.6 \times 10^{-1}$	192	34	16.7
Rh-Chito ⁺ /NaHT	MeOH	1.7x10 ⁻²	305	2	-5.2 ^{a)}

Table 18 Asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate by Rh-Chito and Rh-Chito⁺/NaHT

a) These values deviate  $\pm 5$  % errors since peak areas are considerably small.

b) Hydrogenation of dibutyl itaconate by Rh-Chito at 313 K.

sample	$[\alpha]_D$		
water soluble chitosan	— 8°	(c=0.5, H ₂ O)	
N-Chito-OP	+12 °	(c=0.5, DMF)	
Rh-Chito	+ 8°	(c=0.5, DMF)	
$[Rh((R,R)-norphos)(NBD)]ClO_4^{45}$	$-105$ $^{\circ}$	(c=0.3, MeOH)	

Table 19. Optical rotation of water soluble chitosan, N-Chito-OP and Rh-Chito

Table 20 Hydrogenation of citronellal by [Rh(PPh₃)₂(COD)]PF₆, Rh-Chito and Rh-Chito⁺/NaHT

catalyst	solvents	reaction time / h	yield/%	citronellol (C=O react)	octanal (C=C react)
$[Rh(PPh_3)_2(COD)]PF_6$	MeOH	6	90	2	87
Rh-Chito	MeOH/DMF=1	2260	90	58	33
Rh-Chito ⁺ /NaHT	MeOH/DMF=1	1674	86	44	42











;

Scheme 3. Hydrogenation of citronellal.





Figure 1. Schematic structure of NaHT.



Figure 2. Schematic structures of sugars.



Figure 3. IR spectra for (a) water soluble chitosan and (b) Chito-OP.

.



Figure 4. Plots of viscosity at different molecular weight. ¹⁵⁾



Figure 5. IR spectra for (a) chitosan500, (b) *N*-Chito and (c) *N*-Chito-OP.

•



Figure 6. IR spectra for (a) N-Chito, (b) N-Chito-OTs and (c) N-Chito-P.



Figure 7. IR spectra for (a) [Rh(COD)Cl]₂, (b) *N*-Chito-OP and (c) Rh-Chito.

·







Figure 9. UV spectra for (a)  $Rh(COD)CIO_4S 1/50$  and (b)  $Rh(COD)CIO_4S 1/100$ .



Type II 8/3 helical structure



1 unit

# Figure 10. Conformation of chitosan.



Figure 11. Plausible structure of Rh-Chito.











 $EDS \rightarrow Rh, P, Si, Mg$ 

Figure 14. TEM image of Rh-Chito+/ NaHT.



2/1 helical structure



Figure 15. Plausible structure of Rh-Chito⁺/NaHT.



Time / h

Figure 16. Asymmetric hydrogenation of dibutyl itaconate by Rh-Chito in DMF at 313 K.



Time / h





Figure 18. Asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate by Rh-Chito in MeOH/DMF=30 at 303 K.



Time / h

Figure 19. Asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate by Rh-Chito in EtOH/DMF=1 at 303 K.







Time / h





Time / h

Figure 21. Asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate by Rh-Chito⁺/NaHT in MeOH/DMF=30 at 303 K.



Time / h

Figure 22. Asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate by Rh-Chito⁺/NaHT in EtOH/DMF=1 at 303 K.



Time / h





Figure 24. Solvent effect on selectivity in asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate by Homo: Rh-Chito and Hetero: Rh-Chito+/NaHT.



Figure 25. Mechanistic scheme for equilibrium state.



Figure 26. Mechanistic scheme for the Rh-Chito⁺ -catalayzed asymmetric hydrogenation of itaconates.



Figure 27. Schematic drawing showing the four aryls (face and edge structure).

Rh-Chito (in homogeneous system)

S.







Time / h

Figure 29. Hydrogenation of geraniol by  $[Rh(PPh_3)_2(COD)]PF_6$  in MeOH at 303 K.

50.28



Time / h

Figure 30. Hydrogenation of citronellal by  $[Rh(PPh_3)_2(COD)]PF_6$  in MeOH at 303 K.



Time / h

Figure 31. Hydrogenation of citronellal by Rh-Chito in MeOH/DMF=1 at 303 K.



Time / h

Figure 32. Hydrogenation of citronellal by Rh-Chito⁺/NaHT in MeOH/DMF=1 at 303 K.







